PATENT ABSTRACTS OF JAPAN

(11)Publication number:

2004-182781

(43)Date of publication of application: 02.07.2004

(51)Int.Cl.

CO9K 11/59

CO9K 11/08

CO9K 11/63

CO9K 11/65

CO9K 11/66

CO9K 11/67

H01L 33/00

(21)Application number: 2002-348387

(71)Applicant: NICHIA CHEM IND LTD

(22)Date of filing:

29.11.2002

(72)Inventor:

KAMESHIMA MASATOSHI

TAMAOKI HIROTO

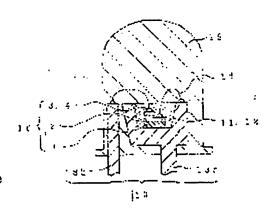
(54) NITRIDE PHOSPHOR AND LIGHT-EMITTING EQUIPMENT USING THE SAME

(57)Abstract:

PROBLEM TO BE SOLVED: To provide a light-emitting device which emits white light of a reddish warm color type with good luminous efficiency, a phosphor which has an emission spectrum in the yellow to red region and is used in combination with a blue light-emitting device or the like.

SOLUTION: The nitride phosphor is represented by the formula: LXMYN((2/3)X+(4/3)Y):R or

LXMYOZN((2/3)X+(4/3)Y-(2/3)Z):R (wherein L is a group II element to be selected from the group consisting of Ca, Sr, Ba and the like; M is a group IV element to be selected from the group consisting of Si, Ge and the like; R is a rare earth element to be selected from the group consisting of Eu and the like; and X, Y, and Z are $0.5 \le X \le 3$, $1.5 \le Y \le 8$, and 0<Z≤3, respectively) and contains 1 ppm to 10,000 ppm B. The light-emitting equipment is constituted of the above



nitride phosphor which converts the wavelength of part of the light from a blue light-emitting device 10 to have a peak wavelength in the yellow to red region. (19) 日本国特許庁(JP)

(12)公開特許公報(A)

(11)特許出願公開番号

特開2004-182781 (P2004-182781A)

(43) 公開日 平成16年7月2日 (2004.7.2)

			(42) App [1	1 44 10 4 17 3	EH (EVV4. 1. E)
(51) Int.C1. ⁷	FI			テーマコー	ド(参考)
CO9K 11/59	CO9K	11/59	CQH	4H001	
CO9K 11/08	CO9K	11/08	D	5F041	
CO9K 11/63	CO9K	11/08	J		
CO9K 11/65	CO9K	11/63			
CO9K 11/66	CO9K	11/65			
	審査請求 未	請求 請求	項の数 14 〇L	(全 30 頁)	最終頁に続く
(21) 出願番号	特願2002-348387 (P2002-348387)	(71) 出願丿	人 000226057		
(22) 出願日	平成14年11月29日 (2002.11.29)		日亜化学工業材	株式会社	
			徳島県阿南市」	L中町岡491	番地100
		(72) 発明者	いく		
			徳島県阿南市」	L中町岡491	番地100
			日亜化学工業権	株式会社内	
		(72) 発明者	大寛 寛正 曾		
			徳島県阿南市」	L中町岡491	番地100
		1			

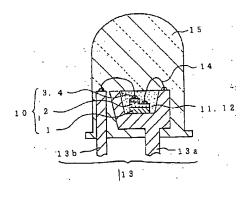
最終頁に続く

(54) 【発明の名称】 窒化物蛍光体及びそれを用いた発光装置

(57)【要約】

【課題】発光効率の良好な赤みを帯ひた暖色系の白色の 発光装置を提供すること、青色発光素子等と組み合わせ て使用する黄から赤領域に発光スペクトルを有する蛍光 体を提供することを目的とする。

【選択図】 図1



【特許請求の範囲】

【請求項1】

Y、La、Ce、Pr、Nd、Sm、Eu、Gd、Tb、Dy、Ho、Er、Luからなる群から選ばれる少なくとも 1 種以上の希土類元素により賦活される、

Be、Mg、Ca、Sr、Ba、Znからなる群から選ばれる少なくとも1種以上の第II族元素と、

C、Si、Ge、Sn、Ti、区と、Hfからなる群から選ばれる少なくとも1種以上の 第IV族元素と、

Nγ.

を含む窒化物蛍光体であって、

該室化物蛍光体は、Bが1PPM以上10000PPM以下含まれていることを特徴とする窒化物蛍光体。

【請求項2】

前記室化物蛍光体の組成中には、Oか含まれていることを特徴とする請求項1に記載の窒化物蛍光体。

【請求項3】

一般式、 L_X M_Y $N_{((2/3)}$ X_{+} (4/3) $Y_{)}$: R 若しくは L_X M_Y O_X $N_{((2/3))}$ X_{+} (4/3) Y_{-} (2/3) X_{-} (2/3)

該窒化物蛍光体は、Bか1PPm以上10000PPm以下含まれていることを特徴とする窒化物蛍光体。

【請求項4】

第1の発光スペクトルの少なくとも一部を波長変換し、前記第1の発光スペクトルと異なる領域に第2の発光スペクトルを少なくとも1以上有する窒化物蛍光体であって、

前記室化物蛍光体の原料に対して、添加量を制御自在となるように添加されたBが含まれることを特徴とする窒化物蛍光体。

【請求項5】

前記室化物蛍光体の結晶構造は、単斜晶又は斜方晶であることを特徴とする請求項1乃至 4の少なくともいずれが一項に記載の窒化物蛍光体。

【請求項6】

前記希土類元素は、Euを必須とする少なくとも1種以上の元素であることを特徴とする 請求項1又は3のいずれかに記載の窒化物蛍光体。

【請求項7】

前記室化物蛍光体は、さらに、Li、Nの、K、Rb、CSからなる群から選ばれる少なくとも1種以上の第1族元素が0.1以上500PPm以下含まれていることを特徴とする請求項1乃至6の少なくともいずれか一項に記載の窒化物蛍光体。

【請求項8】

前記室化物蛍光体は、さらに、Cu、Ag、Auからなる第Ⅰ族元素、Al、Ga、Inからなる第ⅠIL族元素、Ti、区ケ、Hf、Sn、Pbからなる第ⅠV族元素、P、Sb、Biからなる第V族元素、Sからなる第VI族元素がBuがれる少なくとも1種以上の元素がO.1以上500PPm以下含まれていることを特徴とする請求項1乃至7の少なくともいずれか一項に記載の窒化物蛍光体。

【請求項9】

前記室化物蛍光体は、さらに、Ni、CYのいずれかの元素が1以上500PPm以下含まれていることを特徴とする請求項1乃至8のいずれか一項に記載の窒化物蛍光体。

10

20

30

40

【請求項10】

前記室化物蛍光体は、平均粒径が2以上15μm以下であることを特徴とする請求項1乃至9の少なくともいずれが一項に記載の窒化物蛍光体。

【請求項11】

近紫外がら可視光の短波長領域の光を放出する励起光源と、

該励起光源からの光の少なくとも一部を波長変換し、励起光源の光よりも長波長領域の光を放出する蛍光体と、

を有する発光装置であって、

前記蛍光体は、請求項1乃至10の少なくともいずれか一項に記載の窒化物蛍光体を少なくとも有していることを特徴とする発光装置。

【請求項12】

前記蛍光体は、さらに青色に発光する蛍光体、緑色に発光する蛍光体、黄色に発光する蛍光体の少なくともいずれか1以上を有していることを特徴とする請求項11に記載の発光装置。

【請求項13】

前記励起光源は、半導体発光素子であることを特徴とする請求項11に記載の発光装置。 【請求項14】

前記発光装置は、前記蛍光体の粒子間を透過する前記励起光源からの光の一部と、

前記励起光源がらの光により波長変換される、前記蛍光体から放出される光の一部と、 が混合されて放出されることにより白色系に発光することを特徴とする請求項11乃至1

3の少なくともいずれか一項に記載の発光装置。

【発明の詳細な説明】

[0001]

【発明の属する技術分野】

本発明は、半導体発光素子、蛍光ランプ等の照明、ディスプレイ、液晶用パックライト等に使用される発光装置、特に発光装置に使用される窒化物蛍光体に関する。

[0002]

【従来の技術】

半導体素子を用いた発光装置は、小型で電力効率が良く鮮やかな色の発光をする。また、発光素子ランプに用いられる発光素子は、半導体素子であるため球切れなどの心配がない。さらに初期駆動特性が優れ、振動やオン・オフ点灯の繰り返しに強いという特徴を有する。このような優れた特性を有するため、半導体発光素子は、各種の光源として利用されている。

[0003]

[0004]

【特許文献1】

国際公開第01/40403号パンフレット

20

10

[0005]

【発明が解決しようとする課題】

しかし、青色に発光する発光素子と、黄色の蛍光を発する蛍光体と、からなる発光装置は 、赤色成分が少なく、赤みの不足し友斉白い白色として、見えている。そのため、赤みを 帯びた白色に発光する発光装置が求められている。

[0006]

特許文献1の室化物蛍光体は、輝度が低く、十分な発光が得られていないという問題を有 している.

[0007]

従って、本発明は上記問題を解決し、発光効率が高い蛍光体を提供することを目的とする 。また、該蛍光体を用いた発光装置を提供することを目的とする。

[0008]

【課題を解決するための手段】・

上記課題を解決するため、本発明は、Y、La、Ce、Pr、Nd、Sm、Eu、Gd、 T b 、 D y 、 H o 、 E r 、 L u からなる群から選ばれる少なくとも 1 種以上の希土類元素 により賦活される、Be、M9、Ca、Sr、Ba、Znからなる群から選ばれる少なく とも1種以上の第11族元素と、C、Si、Ge、Sn、Ti、Zr、Hfからなる群か ら選ばれる少なくとも1種以上の第IV族元素と、Nと、を含む窒化物蛍光体であって、 該窒化物蛍光体は、Bが1PPm以上10000PPm以下含まれていることを特徴とす る窒化物蛍光体に関する。これにより、発光輝度、量子効率等の発光特性の向上を図るこ とができる。この効果の原因は明らかではないが、ホウ素元素が添加されることにより、 賦活剤の拡散が生じ、粒子の成長が促進されていると考える。また、ホウ素元素が結晶格 子内に入り込み、該結晶格子の歪みを無くしたり、発光機構に関与したりして、発光輝度 、量子効率などの発光特性の改善を図っていると考えている。

[0009]

前記室化物蛍光体は、Euにより賦活される、Ca及びSrの少なくともいずれか1元素 と、Siと、Nと、からなる窒化物蛍光体である。Euの一部は、Y、Lの、Ce、PF 、Nd、Sm、Gd、Tb、Dソ、HO、Er、Luからなる群から選ばれる少なくとも 1種以上の希土類元素により置換可能である。C瓜及びSrの少なくともいずれか一方の 元素の一部は、Be、Mf、Ba、Znからなる群から選ばれる少なくとも1種以上の第 II族元素により置換可能である。Siの一部は、C、Ge、Sn、Ti、Zr、Hfか らなる群から選ばれる少なくとも1種以上の第1V族元素により置換可能である。

[0010]

本発明は、前記室化物蛍光体の組成中には、〇が含まれていることを特徴とする室化物蛍 光体に関する。これにより、酸素を含む原料を用いることができため、製造しやすくする ことができる。

[0011]

本発明は、一般式、 L _X M _Y N _{((2/3) X + (4/3) Y)} : R 若しくは L _X M _Y O z N ((2/3) x + (4/3) y - (2/3) z) : R (Lは、Be、Mタ、Ca、S r、Ba、Znからなる群から選ばれる少なくとも1種以上の第11族元素である。Mは 、C、Si、Ge、Sn、Ti、Zr、Hfからなる群から選ばれる少なくとも1種以上 の第IV族元素である。Rは、Y、La、Ce、Pr、Nd、Sm、Eu、Gd、Tb、 Dy、Ho、Er、Luからなる群から選ばれる少なくとも 1 種以上の希土類元素である 。 X 、Y 、 Z は 、 O . 5 ≤ X ≤ 3 、 1 . 5 ≤ Y ≤ 8 、 0 < Z ≤ 3 である。)で表される窒 化物蛍光体であって、該窒化物蛍光体は、Bが1PPm以上10000PPm以下含まれ ていることを特徴とする窒化物蛍光体に関する。窒化物蛍光体は、上記一般式で現すこと ができ、該一般式中にBが含まれている。これにより、発光輝度、量子効率等の発光効率 の向上を図ることができる。

[0012]

本発明は、第1の発光スペクトルの少なくとも一部を波長変換し、前記第1の発光スペク

トルと異なる領域に第2の発光スペクトルを少なくとも1以上有する窒化物蛍光体であって、前記窒化物蛍光体の原料に対して、添加量を制御自在となるように添加されたBが含まれることを特徴とする窒化物蛍光体に関する。これにより、発光輝度、量子効率、残光等の発光特性の調節を行うことができる。ホウ素を添加していない場合は、発光輝度、量子効率等の発光特性は一定であるが、ホウ素を添加することにより、発光輝度の向上を図ったり、残光を短くしたりすることができる。発光特性の調節は、照明用、表示用などの用途に応じて、要求される特性が異なるため、同じ色調で発光特性を変えることが求められているからである。

[0013]

なお、第1の発光スペクトルは、外部装置により励起されたものである。

[0014]

前記室化物蛍光体の結晶構造は、単斜晶又は斜方晶である室化物蛍光体である。前記室化物蛍光体は、結晶構造を持っており、該結晶構造は、単斜晶又は斜方晶である。該結晶構造を持ってとにより、発光効率の良好な室化物蛍光体を提供することができる。

[0015]

前記希土類元素は、Euを必須とする少なくとも1種以上の元素であることが好ましい。 Euを賦活剤に用いることにより、 色から赤色系に発光する蛍光体を提供することができるからである。Euの一部を他の希土類元素で置換することにより、異なる色調、残光特性を有する窒化物蛍光体を提供することができる。

[0016]

20

10

前記室化物蛍光体は、さらに、Li、Nの、K、Rb、CSからなる群から選ばれる少なくとも1種以上の第「族元素が0.1以上500PPm以下含まれていることが好ましい。これにより、発光輝度、量子効率等の発光特性の向上を図ることでる。これは、前記第「族元素が、合成中、フラックスとして働き、その後。フラックスとして働いた第「族元素が蛍光体粒子間に存在するため、若しくは第「族元素が製造工程中に飛散するため、蛍光体の発光そのものを阻害することが少ないからと考えられるからである。また、窒化物蛍光体に第「族元素を含有することにより、窒化物蛍光体の粒径を制御することができる

[0017]

30

前記室化物蛍光体は、さらに、Cu、Ag、Auからなる第1族元素、Al、Ga、Inからなる第111族元素、Ti、Zr、Hf、Sn、Pbからなる第1V族元素、P、Sb、Biからなる第V族元素、Sからなる第VI族元素から選ばれる少なくとも1種以上の元素がO.1以上500PPm以下含まれていることが好ましい。これにより、室化物蛍光体の輝度の調整を行うことができる。

[0018]

前記室化物蛍光体は、さらに、Ni、CPのいずれかの元素が1以上500PPm以下含まれていることが好ましい。これにより、窒化物蛍光体の残光を短くすることができる。Ni、CPの他に、M9、AIも同様の効果を有する。これらM9、AI、Ni、CPの添加量を制御することにより、残光を制御することができる。

[0019]

40

前記室化物蛍光体は、平均粒径が2以上15μm以下であることが好ましい。特に、平均粒径が、3以上12μm以下であることが好ましい。さらに好ましくは、平均粒径が55元とが好ましい。さらに好ましくは、平均粒径が55元とが好ましい。さらに好ましくは、平均粒径が55元をである。粒径を所定の範囲に制御することにより、色むらが極めて少ない、発光装置を提供することができる。 室化物蛍光体の平均粒径が大きいほど、発光輝度が高いが、15μm以上になるで、発光装置に使用する場合は、塗布しにくく、取り扱いにくい。一方、窒化物蛍光体の平均粒径が小さいほど、発光を置の蛍光面に塗布した場合に、均一に発光するが、発光輝度が低いことや、塗布時、製造時にあいて、取り扱いにくいという問題がある。したがって、上記範囲の平均粒径が好ましい。

[0020]

本発明は、近紫外から可視光の短波長領域の光を放出する励起光源からの光の少なくとも一部を波長変し、励起光源の光を放出する発光装置であると、前記蛍光体は、130の少ななを置いなととも同かでは、前記蛍光体は、130の少なな装置に関すると、前記蛍光体は、130の少なな装置に関すると、で、130の変化物度、対しているの変光がでは、130の光でで、100の光でで、100元とは、

[0021]

前記蛍光体は、さらに青色に発光する蛍光体、緑色に発光する蛍光体、黄色に発光する蛍光体の少なくともいずれか1以上を有していることが好ましい。諸種の色味に発光する蛍光体を本発明に係る窒化物蛍光体と組み合わせて使用することにより、白色だけでなくにステルカラー等の所望の発光色を有する発光装置を提供することができる。また、白色であっても、(黄みの)白、(青みの)白等に微調整することもできる。さらに、近紫外の光を放出する励起光源と、窒化物蛍光体、青色に発光する蛍光体、緑色に発光する蛍光体及び黄色に発光する蛍光体の少なくともいずれが1以上の蛍光体と、を同じることにより、白色、バステルカラー等の所望の発光色を有する発光装置を提供することができる。

[0022]

前記励起光源は、半導体発光素子であることが好ましい。半導体発光素子を用いることにより、半導体発光素子の特徴を生かした発光装置を提供することができる。半導体発光素子の特徴は、小型で電力効率が良く鮮やかな色の発光をすること、初期駆動特性が優れ、振動やオン・オフ点灯の繰り返しに強いこと、発光素子ランプに用いられる半導体発光素子は、半導体素子であるため球切れなどの心配がないということ、などである。

[0023]

前記発光装置は、前記蛍光体の粒子間を透過する前記励起光源からの光の一部と、前記聞光源からの光により波長変換される、前記蛍光体から放出されることにより白色系に発光装置に関する。これにより、高いを光支で有する白色系に発光装置を提供することができる。例えば、青色光を光素子により、窒化物蛍光体が励起され黄赤光を発光し、また、できた青色光を発光することにより、窒化物蛍光体及び蛍光体間をすり抜けてきた青色光と、蛍光体の黄赤光と、蛍光体の黄色光とが、光の退色に関する原理によって、人間の日光とが、光が退色に関する原理によって、人間の日光とが、光が退色に関する原理によって、人間の日光とが、光の退色に関する原理によって、人間の日に表光体の黄赤光と、電光体の黄色光とが、光の退色評価数(Rの)に優れた発光装置である。該特殊演色評価数(Rの)は、70以上である。

[0024]

明細書における色名と色度座標との関係は、全てJIS規格に基づく(JIS又8110)。

[0025]

以上のように、本発明に係る窒化物蛍光体は、輝度、量子効率等の発光特性が極めて良好な蛍光体である。本発明に係る発光装置は、発光効率の高いやや赤みを帯びた暖色系の白色の発光装置を提供することができる。該発光装置は、平均演色評価数(Ra)、特殊演色評価数(R9)に優れた発光装置である。また、青色系に発光する半導体発光素子と本発明に係る窒化物蛍光体とを組み合わせる発光装置、近紫外に発光する半導体発光素子と

20

30

40

、本発明に係る窒化物蛍光体と、緑色に発光する蛍光体と、黄色に発光する蛍光体と、を組み合わせる発光装置を提供することにより、白色系、又は、パステルカラーなどに発光する発光装置を提供することができる。従って、本発明は、窒化物蛍光体、及び、それを用いた発光装置を提供することができるという技術的意義を有する。

[0026]

【発明の実施の形態】

以下、本発明に係る蛍光体及びせの製造方法を、実施の形態及び実施例を用いて説明する。だたし、本発明は、この実施の形態及び実施例に限定されない。

[0027]

本発明に係る発光装置は、第1の発光スペクトルを有する発光素子と、前記第1の発光スペクトルの少なくとも一部を波長変換し、第2の発光スペクトルを有する蛍光体と、を少なくとも有する発光装置である。具体的な発光装置の一例として、図1を用いて説明する。図1は、本発明に係る発光装置を示す図である。

[0028]

(発光装置1)

発光装置1は、サファイア基板1の上部に積層された半導体層2と、該半導体層2に形成された正角の電極3から延び3導電性ワイヤ14で導電接続されたリードフレーム13と、該サファイア基板1と該半導体層2とから構成される発光素子10の外周を覆うようにリードフレーム13ののカップ内に設けられた蛍光体11とコーティング部材12と、該蛍光体11及び該リードフレーム13の外周面を覆うモールド部材15と、から構成されている。

[0029]

サファイア基板1上に半導体層2が形成され、該半導体層2の同一平面側に正負の電極3が形成されている。前記半導体層2には、発光層(図示しない)が設けられており、この発光層から出力されるピーク波長は、紫外から青色領域の500mm以下近傍の発光スペクトルを有する。

[0030]

この発光素子10をダイボンダーにセットし、カップが設けられたリードフレーム18のにフェイスアップしてダイボンド(接着)する。ダイボンド後、リードフレーム18をワイヤーボンダーに移送し、発光素子の負電極3をカップの設けられたリードフレーム18 a に金線でワイヤーボンドし、正電極3をもすーカのリードフレーム18 b にワイヤーボンドする。

[0031]

次に、モールド装置に移送し、モールド装置のディスペンサーでリードフレーム 1 3 のカップ内に蛍光体 1 1 及びコーティング部材 1 2 を注入する。蛍光体 1 1 とコーティング部材 1 2 とは、予め所望の割合に均一に退合しておく。

[0032]

蛍光体11注入後、予めモールド部材15が注入されたモールド型枠の中にリードフレーム13を浸漬した後、型枠をはずして樹脂を硬化させ、図1に示すような砲弾型の発光装置1とする。

[0033]

例えば、蛍光体11に窒化物蛍光体のみを使用する。蛍光体11は、発光素子10によって発光された紫外から青色領域の光の一部を吸収して黄から赤色領域の光を発光する。この蛍光体11を上記の構成を有する発光装置に使用して、発光素子10により発光された青色光と、蛍光体の赤色光とが退色により暖色系の白色に発光する発光装置を提供する。該発光装置は、JIS規格に沿うように、電球色に発光する発光装置を製造する。

[0034]

電球色とは、JIS規格(JIS 又8110)による白色系で黒体 射の軌跡上の2700~2800Kの点を中心とする範囲であって、黄色から赤色の色味を有している色味をいう。具体的には、図7の色度座量における、(うすい)黄赤、(オレンジ)ピンク、

.

จก

20

40

ピンク、(うすい)ピンク、(黄みの)白の領域に発光色を有するものをいう。

[0035]

(発光装置2)

上記の発光装置1と異なる発光装置2についての具体的構成について詳述する。図8は、 本発明に係る発光装置とを示す図である。発光装置とは、表面実装型の発光装置を形成す る。発光素子101は、紫外光励起の窒化物半導体発光素子を用いることができる。また 、発光素子101は、青色光励起の窒化物半導体発光素子も用いることもできる。ここで は、紫外光励起の発光素子101を例にとって、説明する。発光素子101としてLED チップ101は、発光層としてピーク波長が約370mmのInGaN半導体を有する室 化物半導体発光素子を用いる。より具体的なLEDの素子構造としてサファイア基板上に 、アンドープの窒化物半導体であるり型はのN層、8iドープのり型電極が形成されり型 コンタクト層となるGAN層、アンドープの窒化物半導体であるり型GAN層、窒化物半 導体であるり型AIGaN層、次に発光層を構成するInGaN層の単一量子井戸構造と してある。発光層上にはM3がドープされたP型クラッド層としてAIGAN層、M3が ドープされたP型コンタクト層であるGAN層を順次積層させた構成としてある。(なお 、サファイア基板上には低温でGAN層を形成させパッファ層とさせてある。また、P型 半導体は、成膜後400℃以上でアニールさせてある。)。エッチングによりサファイア 基板上の窒化物半導体に同一面側で、Pn各コンタクト層表面を露出させる。露出された n型コンタクト層の上にn電極を帯状に形成し、切除されずに残ったP型コンタクト層の ほぼ全面に、金属薄膜がら成る透光性P電極が形成され、さらに透光性P電極の上にはり 電極と平行に台座電極がスパッタリング法を用いて形成されている。

[0036]

次に、中央部に凹部有し且つ前記凹部の両側にコパール製のリード電極102が気密絶縁的に挿入固定されたペース部とからなるコパール製パッケージ105を用いる。前記パッケージ105及びリード電極102の表面にはNi/A9層が設けられている。パッケージ105の凹部内に、A9-8m合金にて上述のLEDチップ101をダイボンドする。このように構成することにより、発光装置の構成部材を全て無機物とすることができ、LEDチップ101から放出される発光が紫外領域或いは可視光の短波長領域であったとしても飛躍的に信頼性の高い発光装置が得られる。

[0037]

次に、タイポンドされたLEDチップ101の各電極と、パッケージ凹部底面から露出された名リード電極102とをされずれA9ワイヤ104にて電気的導通を取る。パッケッシの凹部内の水分を十分に排除した後、中央部にガラス窓部107を有するコパールリッド106にて封止しシーム溶接を行う。ガラス窓部には、あらかじめニトロセルロース90wt%とアーアルミナ10wt%からなるスラリーに対してBが添加されたCの28 i_5 N $_8$: Eu、(Y $_0$ 、 $_8$ G $_0$ 、 $_2$) $_3$ A $_1$ 5 O $_1$ 2 : C $_2$ 等の蛍光体108を含有させ、リッド106の透光性窓部107の背面に塗布し、220℃にて30分間加熱では、サセることにより色変換部材を構成してある。こうして形成された発光表置を発光するととできる。以下、本発明の各構成のて簡単で量産性、信頼性に優れた発光装置とすることできる。以下、本発明の各構成について詳述する。

[0038]

以下、本発明に係る発光装置の構成部材について詳述する。

[0039]

(蛍光体)

本発明に係る蛍光体は、 Y、 L α 、 C e、 P r、 N d、 S m、 E u、 G d、 T b、 D y、 H O、 E r、 L u からなる群から選ばれる少なくとも 1 種以上の希土類元素により賦活される、 B e、 M b、 C α 、 S r、 B α 、 Z n からなる群から選ばれる少なくとも 1 種以上の第 I I 族元素と、 C、 S i、 G e、 S n、 T i、 Z r、 H f からなる群から選ばれる少なくとも 1 種以上の第 I V 族元素と、 N と、 を含む窒化物蛍光体であって、 該窒化物蛍光

U

20

30

40

体は、Bが1PPm以上10000PPm以下含まれていることを特徴とする窒化物蛍光体である。又は、該窒化物蛍光体の組成中に、Oが含まれている窒化物蛍光体である。上記窒化物蛍光体の組成中に、Oが含まれている窒化物蛍光体であることがはまれる、Ca及び8Pの少なくともいることを特徴とする窒化物蛍光体であることが好ましい。Eいの一部は、Y、La、Ce、Pr、Nd、8m、Gd、Tb、Dy、Ho、Er、Luからなる群から選ばれる少なくとも1種以上の希土類元素により置換可能である。Ca及び8Pの少なくとも1種以上の新土類元素により置換可能である。8にの一部は、C。の少なくとも1種以上の第11族元素により置換可能である。8にの一部は、C。素により置換可能である。

[0040]

本発明に係る蛍光体は、具体的には、一般式、LxMYN((2)3)x+(4)3)Y) : R若しくはLx My Ox N((2/3) x + (4/3) y - (2/3) x) : R(L は、Be、Mf、Ca、Sr、Ba、Znからなる群から選ばれる少なくとも1種以上の 第II族元素である。Mは、C、Si、Ge、Sn、Ti、Zr、Hfからなる群から選 はれる少なくとも1種以上の第1V族元素である。Rは、Y、La、Ce、Pr、Nd、 Sm、Eu、Gd、Tb、Dy、Ho、Er、Luからなる群から選ばれる少なくとも1 種以上の希土類元素である。X、Y、Zは、0. $5 \le X \le 3$ 、1. $5 \le Y \le 8$ 、 $0 < Z \le$ 3である。)で表される窒化物蛍光体であって、該窒化物蛍光体は、 B が 1 P P M 以上 1 0000PPm以下含まれていることを特徴とする窒化物蛍光体である。一般式の具体例 $VU7tt(Sr_TCa_{1-T})_2Si_5N_8:Eu.Ca_2Si_5N_8:Eu.Sr_TC$ a_{1-T} Si $_{7}$ N $_{10}$: Eu, SrSi $_{7}$ N $_{10}$: Eu, CaSi $_{7}$ N $_{10}$: Eu, Sr $_2$ S i $_5$ N $_8$: E u 、 B $_2$ S i $_5$ N $_8$: E u 、 M $_2$ S i $_5$ N $_8$: E u 、 $_2$ S i $_5$ $N_8 : Eu. SrSi_7 N_{10} : Eu. BaSi_7 N_{10} : Eu. M9Si_7 N_{10} : E$ u. ZnSi, N, 0 : Eu. Sr, Ge, N, Eu. Ba, Ge, N, Eu. M, 2 Ge 5 N 8 : Eu . Zn 2 Ge 5 N 8 : Eu . SrGe 7 N 1 0 : Eu . BaGe 7 N 10: Eu. M&Ge, N10: Eu. ZnGe, N10: Eu. Sr1. 8 Cao. 2 Si 5 N 8 : Eu . Ba 1 . 8 Ca 0 . 2 Si 5 N 8 : Eu . M 9 1 . 8 Ca 0 . 2 Si 5 N 8 : E u . Z n 1 . 8 C a o . 2 S i 5 N 8 : E u . S r o . 8 C a o . 2 S i 7 N 10: Eu. Bao. 8 Cao. 2 Si 7 N 10: Eu. M 90. 8 Cao. 2 Si 7 N 10: Eu. Zno. 8 Cao. 2 Si7 N10: Eu. 8 ro. 8 Cao. 2 Ge7 N 10: Eu. Bao. 8 Cao. 2 Ge, N, 0: Eu. M, 0. 8 Cao. 2 Ge, N 10 : Eu. Zno. 8 Cao. 2 Ge7 N10 : Eu. 8 ro. 8 Cao. 2 8 i 8 G eN₁₀: Eu. Ba_{0.8} Ca_{0.2} Si₈ GeN₁₀: Eu. M_{90.8} Ca_{0.2} $Si_{\theta}GeN_{10}:Eu.Zn_{0.8}Ca_{0.2}Si_{\theta}GeN_{10}:Eu.Sr_{2}Si_{5}$ N 8 : Pr. Ba 2 S i 5 N 8 : Pr. Sr 2 S i 5 N 8 : T b . Ba G e 7 N 1 0 : C e(O<T<1である。)等で表される窒化物蛍光体を使用することが好ましい。

[0041]

この窒化物蛍光体は、一般式、 L_X M_Y $N_{(12/3)}$ x_{+} (4/3) Y_Y) : R 若しくは L_X M_Y O_X O_X O

20

30

40

、原料に所定量を秤量して、添加する。原料へのホウ素の添加量と、焼成後のホウ素の含 有量とは、必ずしも一致しない。ホウ素は、製造工程における焼成段階で、一部が飛散す るため、焼成後のホウ素の含有量は、原料への添加時よりも少ない。

[0042]

Lは、Be、M3、Ca、Sr、Ba、Znからなる群から選ばれる少なくとも1種以上 の第11族元素である。その左め、M3、Ca、Srなどを単独で使用することもできる が、CaとSr、CaとM3、CaとBa、CaとSrとBaなどの組合せも可能である 。特に、窒化物蛍光体の組成にCAとSFの少なくともいずれか一方を用いることにより 、発光輝度、量子効率等にすぐれた蛍光体を提供することができる。このC瓜とSFの少 なくともいずれか一方の元素を有しており、CaとSrの一部を、Be、Mst、Ba、Z n で置換してもよい。 2 種以上の混合物を使用する場合、所望により配合比を変えること ができる。ここで、SPのみ、若しくは、Cののみのときより、SPとCのとを混合した 方が、より長波長側にピーク波長がシフトする。 S トとC a のモル此が、 7 : 3 若しくは 3:7のとき、Ca、SFのみを用いた場合と比べて、長波長側にピーク波長がシフトし ている。さらに、SFYCAのモル比が、ほぼ5:5の8き、最も長波長側にピーク波長 **がシフトする。**

[0043]

Mは、C、Si、Ge、Sn、Ti、Zr、Hfからなる群から選ばれる少なくとも1種 以上の第1V族元素である。そのため、C、Si、GEなどを単独で使用することもでき るが、CとSi、GeとSi、TiとSi、ZrとSi、GeとTiとSiなどの組合せ も可能である。特に、窒化物蛍光体の組成にSiを用いることにより安価で結晶性の良好 な窒化物蛍光体を提供することができる。Siの一部を、C、Ge、Sn、Ti、Zr、 H f で置換してもよい。Siを必須とする混合物を使用する場合、所望により配合比を変 えることができる。例えば、Siを95重量%用いて、Geを5重量%用いることができ

[0044]

Rt. Y. La. Ce. Pr. Nd. Sm. Eu. Gd. Tb. Dy. Ho. Er. Lu からなる群から選ばれる少なくとも1種以上の希土類元素である。 E u 、 P r 、 C e など を単独で使用することもできるが、CEとEu、PrとEu、LaとEuなどの組合せも 可能である。特に、賦活剤として、Euを用いることにより、黄色から赤色領域にピーク 波長を有する発光特性に優れた窒化物蛍光体を提供することができる。ELの一部を、Y 、La、Ce、Pr、Nd、8m、Gd、Tb、Dy、Ho、Er、Luで置換してもよ い。Euの一部を他の元素で置換することにより、他の元素は、共賦活として作用する。 共賦活とすることにより色調を変化することができ、発光特性の調整を行うことができる 。Euを必須とする混合物を使用する場合、所望により配合比を変えることができる。以 下の実施例は、発光中心に希土類元素であるユウロピウムEuを用いる。ユウロピウムは 、主に2価と3価のエネルギー準位を持つ。本発明の蛍光体は、母体のアルカリ土類金属 系窒化ケイ素に対して、Eu 2 + を賦活剤として用いる。Eu 2 + は、酸化されやすく、 3価のEu2〇3の組成で市販されている。しかし、市販のEu2〇3では、〇の関与が 大きく、良好な蛍光体が得られにくい。そのため、Eu2〇3から〇を、系外へ除去した ものを使用することが好ましい。たとえば、ユウロピウム単体、窒化ユウロピウムを用い ることが好ましい。

[0045]

ホウ素を添加した場合の効果は、 E u ² + の拡散を促進し、 発光輝度、エネルギー効率、 量子効率等の発光特性の向上を図ることができる。また、粒径を大きくし、発光特性の向 上を図ることができる。

[0046]

前記室化物蛍光体は、さらに、Li、Na、K、Rb、CSからなる群から選ばれる少な くとも1種以上の第1族元素を1以上500PPm以下含むこともできる。第1族元素は 、製造工程における焼成時に、飛散する左め、原料への添加当初より、焼成後の添加量の

方が、少なり量となっている。そのため、原料に添加する量を1000PPm以下に調整することが好ましい。これにより、発光輝度等の発光効率の調整を図ることができるからである。第1族元素を添加することにより、上述のように、発光輝度、量子効率の向上を図ることができる。

[0047]

前記室化物蛍光体は、さらに、Cu、Ag、Auからなる第I族元素、Al、Ga、Inからなる第III族元素、Ti、Zr、Hf、Sn、Pbからなる第IV族元素、P、Sb、Biからなる第V族元素、Sからなる第VI族元素から選ばれる少なくとも1種以上の元素を1以上500PPm以下含むこともできる。これらの元素も、第I族元素と同様に、製造工程における焼成時に、これらの元素が飛散するため、原料への添加当初より、焼成後の添加量の方が、少ない量となっている。そのため、原料に添加する量を1000PPm以下に調整することが好ましい。これらの元素を添加することにより、発光効率の調整を行うことができる。

[0048]

前記室化物蛍光体は、さらに、Ni、CFのいずれかの元素を1以上500PPm以下含むこともできる。残光を調節するためである。そのため、原料に添加する量を1000PPm以下に調整することが好ましい。

[0049]

上述の窒化物蛍光体に、さらに加える元素は、通常、酸化物、若しくは酸化水酸化物で加えられるが、これに限定されるものではなく、メタル、窒化物、イミド、アミド、若しくはその他の無機塩類でも良く、また、予め他の原料に含まれている状態でも良い。

[0050]

前記室化物蛍光体の組成中に酸素が含有されている。酸素は、原料となる各種酸化物から導入されるが、焼成中に酸素が退入してくることが考えられる。この酸素は、EL拡散、粒成長、結晶性向上の効果を促進すると考えられる。すなわち、原料に使用される一の化合物をメタル、窒化物、酸化物と変えても同様の効果が得られるが、むしろ酸化物を用いた場合の効果が大きい場合もある。窒化物蛍光体の結晶構造は、単斜晶又は斜方晶があるが、非単結晶、六方晶系などもある。

[0051]

(蛍光体の製造方法)

次に、図2を用いて、本発明に係る蛍光体、Bを含有するC α_2 α_2 α_3 α_4 α_5 α_5 α_6 $\alpha_$

[0052]

原料のCaを粉砕する(P1)。原料のCaは、単体を使用することが好ましいが、イミド化合物、アミド化合物などの化合物を使用することもできる。また原料Caは、し、、Na、K、B、AIなどを含有するものでもよい。原料は、精製したものが好ましい。これにより、精製工程を必要としないため、蛍光体の製造工程を簡略化でき、安価な窒化物蛍光体を提供することができるからである。原料のCaは、アルゴン雰囲気中、グローブホックス内で粉砕を行う。Caの粉砕の目安としては、平均粒径が約0.1μm以上15μm以下の範囲であることが、他の原料との反応性、焼成時及び焼成後の粒径制御などの観点から好ましいが、これに限定されない。Caの純度は、2N以上であることが好ましいが、これに限定されない。

[0053]

原料のCaを、窒素雰囲気中で窒化する(P2)。この反応式を、化1に示す。

[0054]

【化1】

10

20

30

40

[0055]

Caの室化物を粉砕する(P3)。Caの窒化物を、アルゴン雰囲気中、若しくは、窒素雰囲気中、グロープボックス内で粉砕を行う。

[0056]

10

20

[0057]

原料のSiを、窒素雰囲気中で窒化する(P5)。この反応式を、化2に示す。

[0058]

【化2】

38i + 2N₂ † Si₃N₄

ケイ素 S i も、窒素雰囲気中、 8 0 0 ~ 1 2 0 0 ℃、約 5 時間、窒化して、窒化ケイ素を得る。本発明で使用する窒化ケイ素は、高純度のものが好ましい。

[0059]

同様に、Siの窒化物を粉砕する(P6)。

[0060]

次に、Euの化合物Eu2〇3に、Bの化合物H3BO3を湿式混合する(P7)。Euの化合物として、酸化ユウロピウムを使用するが、金属ユウロピウム、窒化ユウロピウムなども使用可能である。このほか、原料のEuは、イミド化合物、アミド化合物を用いることもできる。酸化ユウロピウムは、高純度のものが好ましい。Bの化合物等の異なる元素を湿式混合するが、乾式混合することもできる。これらの混合物は、酸化されやすいものもあるため、Ar雰囲気中、又は、窒素雰囲気中、グローブボックス内で、混合を行う

0

[0061]

40

[0062]

Euの化合物 Eu₂O₃ と、Bの化合物 H₃ BO₃ との混合物 を、酸 化雰囲気中で焼成する(P8)。

[0063]

EuvBの混合物を粉砕する(P9)。粉砕後のEuvBの混合物の平均粒径は、約0.1μmから15μmであることが好ましい。

[0064]

上記粉砕を行った後、Caの窒化物、Siの窒化物、EuとBの混合物を混合する(P10)。

[0065]

P 7 ~ P 9 の工程を省略し、 P 1 0 の工程で、 C a の窒化物、 S i の窒化物、 E u の化合物 E u 2 O 3 、 B の化合物 H 3 B O 3 を、乾式で混合することもできる。

[0066]

C α の 室化物、 β α にの 室化物、 β α と β と

[0067]

【化3】

$$\frac{1.985}{3} \text{ Ca}_{3}\text{N}_{2} + \frac{5}{3}\text{Si}_{3}\text{N}_{4} + \frac{0.015}{2} \text{Eu}_{2}\text{O}$$

[0068]

ただし、各原料の配合比率を変更することにより、目的とする蛍光体の組成を変更することができる。

[0069]

[0070]

また、還元雰囲気は、窒素、水素、アルゴン、二酸化炭素、一酸化炭素、アンモニアの少なくとも 1 種以上を含む雰囲気とする。 ただし、これら以外の還元雰囲気下でも焼成を行うことができる。

[0071]

以上の製造方法を使用することにより、目的とする窒化物蛍光体を得ることが可能である 4

[0072]

(蛍光体)

発光装置に使用される蛍光体は、本発明に係る窒化物蛍光体の他に、青色に発光する蛍光体、緑色に発光する蛍光体、黄色に発光する蛍光体の少なくともいずれか1以上の蛍光体を退合して、使用することができる。

[0073]

青色に発光する蛍光体、緑色に発光する蛍光体、黄色に発光する蛍光体には、種々の蛍光体があるが、特に、少なくともセリウムで賦活されたイットリウム・アルミニウム酸化物 蛍光体、少なくともセリウムで賦活されたイットリウム・ガドリニウム・アルミニウム酸

20

- -

40

化物蛍光体、及び少なくともセリウムで賦活されたイットリウム・ガリウム・アルミニウムで賦活されたイットリウム・カーにより、カートを発光をである。 New York では、 Con york

[0074]

前記イットリウム・アルミニウム酸化物蛍光体等を含有することにより、所望の色度に調 節することができるからである。セリウムで賦活されたイットリウム・アルミニウム酸化 物蛍光体等は、発光素子10により発光された青色光の一部を吸収して黄色領域の光を発 光する。ここで、発光素子10により発光された青色光と、イットリウム・アルミニウム 酸 化 物 蛍 光 体 の 黄 色 光 と が 退 色 に よ り 青 白 い 白 色 に 発 光 す る 。 従 っ て 、 こ の イ ッ ト リ ウ ム ・アルミニウム酸化物蛍光体と前記室化物蛍光体とを透光性を有するコーティング部材と 一緒に退合した蛍光体11と、発光素子10により発光された青色光とを組み合わせるこ とにより暖色系の白色の発光装置を提供することができる。この暖色系の白色の発光装置 は、平均演色評価数Rのが75乃至95であり色温度が2000乃至8000Kである。 特に好ましいのは、平均演色評価数R瓜及び色温度が色度図における黒体放射の軌跡上に 位置する白色の発光装置である。但し、所望の色温度及び平均演色評価数の発光装置を提 供するため、イットリウム・アルミニウム酸化物蛍光体及び本発明に係る蛍光体の配合量 を、適宜変更することもできる。この暖色系の白色の発光装置は、特殊演色評価数R9の 改善を図っている。従来の青色発光素子とセリウムで賦活されたイットリウム・アルミニ ウム酸化物蛍光体との組合せの白色に発光する発光装置は、特殊演色評価数R9がほぼ0 に近く、赤み成分が不足していた。そのため特殊演色評価数R9を高めることが解決課題 となっていたが、本発明に係る蛍光体をイットリウム・アルミニウム酸化物蛍光体中に含 有することにより、特殊演色評価数R9を60乃至70まで高めることができる。ここで 、特殊演色評価数R9は、平均演色評価数とは別の7種類の色票の個々の色ズレを基礎と して求めるもので、7種類の平均ではない。7種類の色票としては、比較的彩度の高い赤 、黄、緑、青、人の皮膚(白人)、木の葉の緑、人の皮膚(日本人)を代表するものが選 ばれている。それぞれ順に、R9、R10、R11、R12、R13、R14、R15と 呼ばれる。このうち、R9は、赤を示す色票である。

[0075]

また、本発明の窒化物蛍光体と組み合わせて用いられる蛍光体は、イットリウム・アルミニウム酸化物蛍光体等に限定されるものではなら第2の発光スペクトルを有するとも1以りなるとも1以りなる。これに発光体を間域は、 前記室化物蛍光体と組み合わせて使用することができる。 窒化物蛍光体と組み合わせて使用することができる。 窒化物蛍光体と組み合わせて使用することができる。 窒化物蛍光体と組み合わせて用することができる。 窒化物蛍光体は、 緑色の原理による白色に発光する発光装置を提供することができる。 窒化物蛍光体 らいるの原理による白色に発光する発光装置を提供することができる。 窒化物蛍光体 らいるのの原理による自由に発光する発光、 日の2025年以上、 日の2025年以上、 日の4030年以上、 日の4030年以上、 日の6030年以上、 日の6030年、 日の6030年、

2 O $_3$: E u 、 G d $_2$ O $_2$ S : E u などをドープすることにより、 所望の発光スペクトルを得ることができる。 但し、 緑色、 青色、 赤色等の発光蛍光体は、 上記の蛍光体に限定されず、 種々の蛍光体を使用することができる。

[0076]

(励起光源)

励起光源は、半導体発光素子、レーサーダイオード、アーク放電の陽光柱において発生する紫外放射、プロー放電の陽光柱において発生する紫外放射などがある。特に、近紫外領域の光を放射する半導体発光素子及びレーザーダイオード、青色に発光する半導体発光素子及びレーザーダイオードが好ましい。

[0077]

近紫外から可視光の短波長領域の光は、270mmから500mm付近までの波長領域をいう。

[0078]

(発光素子)

[0079]

また、半導体の構造としては、MIS接合、PIN接合やPN接合などを有するホモ構造、ヘテロ構造あるいはダブルヘテロ構成のものが好適に挙げられる。半導体層の材料やその混晶比によって発光波長を種々選択することができる。また、半導体活性層を量子効果が生する薄膜に形成させた単一量子井戸構造や多重量子井戸構造とすることでより出力を向上させることもできる。

[0080]

室化物半導体を使用した場合、半導体用基板にはサファイア、スピネル、8iC、8i、 SnO、GaAS、GaN等の材料が好適に用いられる。結晶性の良い窒化物半導体を量産性よく形成させるためにはサファイア基板を利用することが好ましい。このサファイア基板上にHVPE法やMOCVD法などを用いて窒化物半導体を形成させることができる。サファイア基板上にGaN、AIN、GaAIN等の低温で成長させ非単結晶となるパッファ層を形成しその上にPN接合を有する窒化物半導体を形成させる。

[0081]

室化物半導体を使用したPn接合を有する紫外領域を効率よく発光で見れたアースを有する紫外領域を効率よく発光である。をストライプのは、アップを正はTocanを正にOCのでは、アップ上にHVPE法を用いてGのNをELOCのにはいて、MOCCンとでは、MOCCンとでは、MOCCンのでは、MOCCCンのでは、MOCCンのでは、MOCCCンのでは、MOCCCンのでは、MOCCCンのでは、MOCCCンのでは、MOCCCンのでは、MOCCCンのでは、MOCCCンのでは、MOCCCンのでは、MOCCCンのでは、MOCCCOのでは、

[0082]

10

20

30

[0083]

発光装置において、量産性よく形成させるためには透光性封止部材を利用して形成させることが好ましい。特に、蛍光体11を混合して封止することため、透光性の樹脂が好ましい。この場合蛍光体からの発光波長と透光性樹脂の劣化等を考慮して、発光素子は紫外域に発光スペクトルを有し、その主発光波長は360mm以上420mm以下のものや、450mm以上470mm以下のものも使用することができる。

[0084]

ここで、半導体発光素子は、不純物濃度10 1 7 ~10 2 0 / 0 / 0 / 3 で形成される 1 で 3 で形成される 3 で形成は 3 で形成 3 で形成 3 で形成 3 で形成 3 で形成 3 で $^$

[0085]

また、透光性P電極が、金および白金族元素の群から選択された1種と、少なくとも1種との他の元素とから成る多層膜または合金で形成される場合には、含えとで生かよび白金族元素の含有量により透光性P電極のシート抵抗の調整をするとで生かよびにはから上される。金または金属元素は、本発明に使用する半導体発光素の量は少ないほどがよくなる。従来の半導体発光素の関係がRP≤Rnであったがよくなる。従来の半導体発光素の関係がRP≤Rnであったががよくなる。従来の半導体発光素のものと比較して薄膜に形成されることです。このとき金または白金族元素の含有量を減らすことで薄膜化が容易に行える

[0086]

上述のように、本発明で用いられる半導体発光素子は、 N型コンタクト層のシート抵抗 R N Q / □と、 透光性 P 電極のシート抵抗 R P Q / □とが、 R P ≥ R N の関係を成していることが好ましい。 半導体発光素子として形成した後に R N を測定するのは難しく、 R P と R N との関係を知るのは実質上不可能であるが、発光時の光強度分布の状態からどのような R P と R N との関係になっているのかを知ることができる。

[0087]

透光性 P 電極 と n 型 コンタクト層とが R P ≥ R n の関係であるとき、前記透光性 P 電極上に接して延長伝導部を有する P 側台座電極を設けると、さらなる外部量子効率の向上を図ることができる。延長伝導部の形状及び方向に制限はなく、延長伝導部が衛線上である場合、光を遮る面積が減るので好ましいが、メッシュ状でもよい。また形状は、直線状以外に、曲線状、格子状、枝状、 状でもよい。このとき P 側台座電極の総面箱に比例して返光効果が増大するため、遮光効果が発光増強効果を上回らないように延長導電部の線幅及び長さを設計するのがよい。

10

20

31

40

[0088]

(発光素子)

上述の紫外光励起の発光素子と異なる青色光励起の発光素子を使用することもできる。青色光励起の発光素子10は、III属室化物系化合物発光素子であることが好ましい。発光素子10は、例えばサファイア基板1上にGaNパッファ層を介して、8iがアンドープのn型GaN層、8iがドープされたn型GaNがらなるn型コンタクト層、アンドープGaN層、多重量子井戸構造の発光層(GaN障壁層/InGaN井戸層の量子井戸構造)、M3がドープされたP型GaNがらなるP型GaNがらなるPクラッド層、M3がドープされたP型GaNがらなるP型コンタクト層が順次積層された積層構造を有し、以下のように電極が形成されている。但し、この構成と異なる発光素子10も使用できる。【0089】

10

Pオーミック電極は、P型コンタクト層上のほぼ全面に形成され、そのPオーミック電極上の一部にPパッド電極3が形成される。

[0090]

また、 n 電極は、エッチングにより P 型コンタクト層からアンドープ G の N 層を除去して n 型コンタクト層の一部を露出させ、その露出された部分に形成される。

[0091]

なお、本実施の形態では、多重量子井戸構造の発光層を用いたが、本発明は、これに限定されるものではなく、例えば、InGaNを利用した単一量子井戸構造としても良いし、Si、又n等のn型、P型不純物がドープされたGaNを利用しても良い。

20

[0092]

また、発光素子10の発光層は、Inの含有量を変化させることにより、420nmから490nmの範囲において主発光ピークを変更することができる。また、発光波長は、上記範囲に限定されるものではなく、360~550nmに発光波長を有しているものを使用することができる。

[0093]

(コーティング部材)

コーティング部材12(光透光性材料)は、リードフレーム13のカップ内に設けられるものであり発光素子10の発光を変換する蛍光体11と混合して用いられる。コーティング部材12の具体的材料としては、エポキシ樹脂、ユリア樹脂、シリコーン樹脂などの温度特性、耐候性に優れた透明樹脂、シリカゲル、ガラス、無機パインダーなどが用いられる。また、蛍光体11と共に拡散剤、チタン酸パリウム、酸化チタン、酸化アルミニウムなどを含有させても良い。また、光安定化剤や着色剤を含有させても良い。

30

[0094]

(リードフレーム)

リードフレーム 1 8 は、マウントリード 1 8 瓜とインナーリード 1 8 b とから 構成される

[0095]

マウントリード13のは、発光素子10を配置させるものである。マウントリード13のの上部は、カップ形状になってあり、カップ内に発光素子10をダイボンドし、該発光で3・カップ内に発光素子10を変形を112をで覆っている。カップ内に発光素子10を複数配置してウントリード13のを発光素子10の共通をして利用することもできる。この場合、十分な電気伝導性と導電性ワイヤ14との接続性が求められる。発光素子10とマウントリード13のカップとのダイボンド(接着)は、熱硬化性樹脂などによって行うことができる。熱硬化性樹脂などが挙げられる。また、フェースダウンには、エポキシ樹脂、アクリル樹脂、イミド樹脂などが挙げられる。また、フェースダウン発光素子10などによりマウントリード13のとダイボンドすると共に電気的接続を行うには、A3一エースと、カーボンペースト、金属パンプなどを用いることができる。また、無機パインダーを用いることもできる。

[0096]

インナーリード136は、マウントリード13の上に配置された発光素子10の電極3から延びる導電性ワイヤ14との電気的接続を図るものである。インナーリード136は、マウントリード13のとの電気的接触によるショートを避けるため、マウントリード13のから離れた位置に配置することが好ましい。マウントリード13の上に複数の発光素子10を設けた場合は、各導電性ワイヤ同士が接触しないように配置できる構成にする必要がある。インナーリード136は、マウントリード13のと同様の材質を用いることが好ましく、鉄、銅、鉄入り銅、金、白金、銀などを用いることができる。

[0097]

(導電性ワイヤ)

等電性ワイヤ14は、発光素子10の電極3とリードフレーム13とを電気的に接続する 10 ものである。等電性ワイヤ14は、電極3とオーミック性、機械的接続性、電気等電性及び熱伝導性が良いものが好ましい。等電性ワイヤ14の具体的材料としては、金、銅、白金、アルミニウムなどの金属及びそれらの合金などが好ましい。

[0098]

(モールド部材)

モールド部材15は、発光素子10、蛍光体11、コーティング部材12、リードフレーム13及び導電性ワイヤ14などを外部から保護するために設けられている。モールドがお15は、外部からの保護目的の他に、視野角を広げたり、発光素子10からの目的を協和したり、発光を収束、拡散させたりする目的も併せ持っている。これらの目的を達成するためモールド部材は、所望の形状にすることができる。また、モールド部材15はカレンズ形状、凹レンズ形状の他、複数積層する構造であっても良い。モールド部材15の具体的材料としては、エポキシ樹脂、ユリア樹脂、シリコーン樹脂、シリカソル、かの具体的材料としては、エポキシ樹脂、ユリア樹脂、シリコーン樹脂、カラスなどの透光性、耐候性、温度特性に優れた材料を使用することができる。モールド部材15には、拡散剤、着色剤、酸化チタン、酸化フルミニウム等が好ましい。コーティンでご材12との材質の反発性を少なくするため、屈折率を考慮するため、同材質を用いることが好ましい。

[00.99]

以下、本発明に係る蛍光体、発光装置について実施例を挙げて説明するが、この実施例に 限定されるものではない。

[0100]

なお、温度特性は、25 C の発光輝度を100 % とする相対輝度で示す。 粒径は、F . S . S . S . N O . (F i S h e r . S u b . S i e r e r . S i r e r . S .

[0101]

【実施例】

(実施例1乃至4)

表1は、実施例1乃至4の窒化物蛍光体の特性を示す。

[0102]

また、図3は、実施例3の窒化物蛍光体をE×=460mmで励起したときの発光スペクトルを示す図である。図4は、実施例3の窒化物蛍光体の励起スペクトルを示す図である。図5は、実施例3の窒化物蛍光体の反射スペクトルを示す図である。図6は、実施例3の窒化物蛍光体を撮影した8mM写真である。図6(ん)は、1000倍で撮影している。図6(b)は、5000倍で撮影している。

[0108]

【表 1 】

20

ያበ

実施例	Bの添加量 (ppm)	色調×	色調	発光輝度 (%)	量子効率 (%)
1	10	0.596	0.398	100	100
2	200	0.598	0.397	107	108
3	500	0.598	0.396	112	113
4	1000	0.598	0.396	110	112

[0104]

[0105]

実施例1乃至4において、Eu濃度は0.03である。Eu濃度は、Caのモル濃度に対 してのモル比である。

[0106]

まず、原料のCaを1~15μmに粉砕し、窒素雰囲気中で窒化した。その後、Caの窒化物を0.1~10μmに粉砕した。原料のCaを20分秤量し、窒化を行った。

[0107]

同様に、原料のSiを1~15μmに粉砕し、窒素雰囲気中で窒化した。その後、Siの 窒化物を0.1~10μmに粉砕した。原料のSiを20分秤量し、窒化を行った。

[0108]

[0109]

Caの窒化物、Siの窒化物、EuとBの混合物を、窒素雰囲気中で混合した。実施例1乃至4において、原料である窒化カルシウムCa $_3$ N $_2$:窒化ケイ素Si $_3$ N $_4$:酸化ユウロピウムEu $_2$ O $_3$ の各元素の混合比率(モル比)は、Ca:Si:Eu=1.94:5:0.06となるように調整する。この混合比率になるように、Ca $_3$ N $_2$ (分子量148.26)、Si $_3$ N $_4$ (分子量140.31)を、EuとBの混合物を秤量し、混合を行った。Bの添加量は、最終組成の分子量に対して10PPm、200PPm、500PPm、1000PPmである。

[0110]

上記化合物を混合し、焼成を行った。焼成条件は、アンモニア雰囲気中、上記化合物を坩堝に投入し、室温から徐々に昇温して、約1600℃で約5時間、焼成を行い、ゆっくりと室温まで冷却した。一般に、添加していたBは、焼成を行っても組成中に残留しているが、焼成によりBの一部が飛散して、最終生成物中に、当初の添加量よりも少ない量が残存している場合がある。

[0111]

実施例1乃至4の窒化物蛍光体の発光輝度及び量子効率は、実施例1を100%とし、ごれを基準に相対値で表す。

[0112]

表1よりBを10000PPm以下添加したとき、特に1PPm以上1000PPm以下添加したとき、発光輝度、量子効率とも高い値を示した。

[0113]

実施例1万至4の窒化物蛍光体の平均粒径は、 6. 3万至7. 8 μmであった。また、実施例中の蛍光体には、酸素が、 0. 5~1. 2 重量%含有されていた。

0

30

[0114]

実施例に係る窒化物蛍光体は、窒化ホウ素材質の坩堝を用い、アンモニア雰囲気中で焼成を行っている。

[0115]

実施例に係る窒化物蛍光体は、温度特性が極めて良好である。実施例3の窒化物蛍光体の温度特性は、100℃のとき97%、200℃のとき70%であった。

[0116]

実施例1乃至4の窒化物蛍光体は、460mmの励起光源により励起させたとき609mm近傍にピーク波長を有する。

[0117]

(実施例5乃至9)

表2は、実施例5乃至9の窒化物蛍光体の特性を示す。

[0118]

【表2】

実施例	Bの添加量 (ppm)	色調 ×	色調	発光輝度 (%)	量子効率 (%)
.5	10	0.596	0.396	100	100
6	200	0.598	0.396	100	100
7	500	0.598	0.396	100	100
8	1000	0.598	0.396	105	104
9	10000	0.598	0.396	102	101

20

30

[0119]

実施例 5 乃至 9 は、(Cao.97 Euo.og)2Si5 N8 で表される窒化物蛍光体であって、Bを所定量含有している。実施例 5 の窒化物蛍光体を基準に、発光輝度、量子効率を相対値で示す。

[0120]

実施例5乃至9において、Eu濃度は0.03である。Eu濃度は、C α のモル濃度に対してのモル比である。

[0121]

実施例5万至9は、実施例1万至4と製造方法が異なる。

[0122]

まず、原料のこのを1~15μmに粉砕し、窒素雰囲気中で窒化した。その後、このの窒化物を0.1~10μmに粉砕した。原料のこのを20分秤量し、窒化を行った。

[0123]

同様に、原料のS i を $1 \sim 15$ μmに粉砕し、窒素雰囲気中で窒化した。その後、S i の窒化物を0 . $1 \sim 10$ μmに粉砕した。原料のS i を 20 9 秤量し、窒化を行った。

[0124]

Caの塞化物、 Siの塞化物、 Euの化合物Eu $_2$ O $_3$ 、 Bの化合物 H $_3$ B O $_3$ を乾式で混合を行った。 Euの化合物 Eu $_2$ O $_3$ を 2 0 $_3$ 、 H $_3$ B O $_3$ を所定量秤量したものを使用した。 実施例 5 乃至 $_3$ において、 原料である $_3$ 化カルシウム C $_4$ C $_5$ C

[0125]

上記化合物を退合し、焼成を行った。焼成条件は、アンモニア雰囲気中、上記化合物を坩堝に投入し、室温から徐々に昇温して、約1600℃で約5時間、焼成を行い、ゆっくリと室温まで冷却した。

[0126]

実施例5万至9の窒化物蛍光体の発光輝度及び量子効率は、実施例5を100%とし、これを基準に相対値で表す。

[0127]

表2よりBを10000PPm以下添加したとき、発光輝度、量子効率とも高い値を示した。

[0128]

実施例 5 乃至 9 の窒化物 蛍光体の平均粒径は、 6 . 0 乃至 7 . 2 μm であった。酸素濃度は、 0 . 7 ~ 1 . 0 重量 % であった。

[0129]

(実施例10乃至15)

表3は、実施例10乃至15の窒化物蛍光体の特性を示す。

[0 1 3 0]

【表3】

実施例	Bの添加量 (ppm)	色調 ×	色調	発光輝度 (%)	量子効率 (%)
10	10	0.618	0.375	100	100
11	100	0.619	0.374	104	107
12	200	0.620	0.373	105	109
13	500	0.618	0.376	106	105
14	1000	0.620	0.373	97	102
15	5000	0.625	0.368	95	110

20

10

[0131]

実施例10乃至15は、(Sr_{0.97}Eu_{0.03})₂Si₅N8で表される窒化物虫 光体であって、Bを所定量含有している。実施例10の窒化物虫光体を基準に、発光輝度 、量子効率を相対値で示す。

[0132]

実施例10乃至15において、E4濃度は0.03である。E4濃度は、8kのモル濃度 に対してのモル比である。

[0133]

実施例10万至15は、実施例1万至4と、ほぼ同じ製造方法により製造を行った。実施例1万至4で使用したこのに代えて、実施例10万至15は、SFを使用した。実施例1万至4は約1600℃で焼成を行ったが、実施例10万至15は約1850℃で焼成を行った。

[0134]

表3よりBを10000PPm以下添加したとき、特に10PPm以上5000PPm以下添加したとき、発光輝度、量子効率とも高い値を示した。

[0135]

実施例10乃至15の窒化物蛍光体の平均粒径は、2.1乃至4.7μmであった。酸素 40 濃度は、0.3~1.1重量%であった。

[0136]

(実施例16乃至20)

表4は、実施例16乃至20の窒化物蛍光体の特性を示す。

[0 1 3 7]

【表4】

実	拖例	Bの添加量 (ppm)	色調 · x	色調 y	発光輝度 (%)	量子効率 (%)		
<u> </u>	16	10	0.629	0.364	100	100		
 -	17	100	0.628	0.365	101	101		
-	18	500	0.629	0.364	102	103		
	19	1000	0.628	0.365	98	98		
<u></u> ⊢-,	20	5000	0.629	0.364	92	97		

[0138]

実施例16乃至20は、(Sro.g7Euo.o3)2 Si5 N8で表される窒化物蛍 光体であって、Bを所定量含有している。実施例16の窒化物蛍光体を基準に、発光輝度 、量子効率を相対値で示す。

[0189]

実施例16万至20において、Eu濃度は0.03である。Eu濃度は、SFのモル濃度に対してのモル比である。

[0140]

実施例16万至20は、実施例1万至4と、ほぼ同じ製造方法により製造を行った。実施例1乃至4で使用したCのに代えて、実施例16万至20は、8ヶを使用した。

[0141]

表4よりBを1000PPm以下添加したとき、特に10PPm以上500PPm以下添 20 加したとき、発光輝度、量子効率とも高い値を示した。

[0142]

実施例16万至20の窒化物蛍光体の平均粒径は、3.2万至3.9mmであった。

[0143]

(実施例21乃至26)

表5は、実施例21乃至26の窒化物蛍光体の特性を示す。

[0144]

【表 5 】

実施例	Bの添加量	色調	色調	発光輝度	量子効率
!	(ppm)	X	<u>y</u> .	(%)	(%)
21	10	0.636	0.357	100	100
22	100	0.635	0.357	100	100
23	200	0.636	0.356	102	103
24	500	0.636	0.356	101	102
25	1000	0.636	0.356	98	99
26	5000	0.636	0.356	88	105

30

[0145]

実施例21万至26は、(Cao 2858 ro 685 Euo 03) 2 S 15 N 8 で表される窒化物蛍光体であって、B を所定量含有している。実施例21の窒化物蛍光体を 40 基準に、発光輝度、量子効率を相対値で示す。

[0146]

実施例21乃至26において、Eu濃度は0.03である。Eu濃度は、CのとSFとの退合物のモル濃度に対してのモル此である。

[0147]

実施例21万至26は、実施例1万至4と、ほぼ同じ製造方法により製造を行った。実施例1万至4で使用したCaに代えて、実施例21万至26は、CaとSrの混合物を用い、CaとSrのモル比は、3:7である。

[0148]

表 5 より B を 5 0 0 0 P P m 以 下 添 加 し 友 と き 、 特 に 1 0 P P m 以 上 1 0 0 0 P P m 以 下

添加したとき、発光輝度、量子効率とも高い値を示した。

[0149]

実施例21乃至26の窒化物蛍光体の平均粒径は、1.6乃至2.0μmであった。

[0150]

<発光装置1>

発光装置1は、赤味成分を付加した白色発光装置に関する。図1は、本発明に係る発光装置1を示す図である。図7は、本発明に係る発光装置1の色度座標を示す図である。

[0151]

発光装置1は、サファイア基板1上にn型及びP型のGaN層の半導体層2が形成され、 該n型及びP型の半導体層2に電極3が設けられ、該電極3は、導電性ワイヤ14により リードフレーム13と導電接続されている。発光素子10の上部は、蛍光体11及びコー ティング部材12で覆われ、リードフレーム18、蛍光体11及びコーティング部材12 等の外周をモールド部材15で覆っている。半導体層2は、サファイア基板1上にn゚ G an: Si, n-AlGan: Si, n-Gan, Ga.Inn QWS, P-Gan: M す、P-AIGaN:M3、P-GaN:M3の順に積層されている。該n + GaN:S i 層の一部はエッチングされてn 型電極が形成されている。該P - G a N : M 9 層上には 、P型電極が形成されている。リードフレーム13は、鉄入り銅を用いる。マウントリー ド13のの上部には、発光素子10を積載するためのカップが設けられており、該カップ のほぼ中央部の底面に該発光素子10かダイボンドされている。導電性ワイヤ14には、 金を用い、電極3と導電性ワイヤ14を導電接続するためのパンプ4には、Niメッキを 施す。蛍光体11には、実施例49の蛍光体とYAG系蛍光体とを退合する。コーティン プ部材12には、エポキシ樹脂と拡散剤、チタン酸パリウム、酸化チタン及び前記蛍光体 11を所定の割合で混合したものを用いる。モールド部材15は、エポキシ樹脂を用いる 。 こ の 砲 弾 型 の 発 光 装 置 1 は 、 モ ー ル ド 部 材 1 5 の 半 径 2 ~ 4 m m 、 髙 さ 約 7 ~ 1 0 m m の上部が半球の円筒型である。

[0152]

発光装置1に電流を流すと、ほぼ460mmで励起する第1の発光スペクトルを有する青色発光素子10が発光し、この第1の発光スペクトルを、半導体層2を覆う蛍光体11か色調変換を行い、前記第1の発光スペクトルと異なる第2の発光スペクトルを有する。また、蛍光体11中に含有されているYAG系蛍光体は、第1の発光スペクトルにより、第3の発光スペクトルを示す。この第1、第2及び第3の発光スペクトルが互いに退色となり赤みを帯びた白色に発光する発光装置1を提供することができる。

[0153]

[0154]

発光装置1の蛍光体11の重量比は、コーティング部材: (Y-Gd-Al-O:Ce)の蛍光体:実施例15の蛍光体=10:3.8:0.6である。一方、発光装置2の蛍光体の重量比は、コーティング部材: (Y-Gd-Al-O:Ce)の蛍光体=10:3.6の重量比で混合している。

[0155]

0

20

30

本発明に係る発光装置1と、青色発光素子及びY-Gd-AI-O:CEの蛍光体とを用いた発光装置とを比較する。表6は、発光装置1と比較となる発光装置の測定結果を示す

【0156】 【表6】

	電流 IF (mA)	電圧 VF (V)	放射分析 Radiometric (mW)	光度測定 Photometric (lm)	ピーク波長 Peak (nm)	学值幅 FWHM (nm)	視波長 Dominant (nm)
青色LED	20	4,05	14.78	0.955	464.02	19,35	488.05
青色LED+YAG	20	3.75	9.59	3.042	463,47	150.73	568.85
青色LED+YAG+ 窒化物蛍光体	20	3.80	5.84	1.890	596.00	196.36	582.75

10

	色鯛	色調 y	色温度 Tcp (K)	平均演色性 Ra	発光効率 (Im/W)
青色LED	0.134	0,057	-	-	11,8
青色LED+YAG	0.348	0.367	4939	78	40.6
青色LED+YAG+ 窒化物蛍光体	0.454	0.416	2828	76	24.9

20

[0157]

比較となる発光装置と比較して色調はほとんど変化していないが、演色性が改善されている。比較となる発光装置では、特殊演色評価数 R 9 が不足していたが、発光装置 1 では、R 9 の改善が行われている。特殊演色評価数 R 9 は、比較的彩度の高い赤色の標準色からの色ずれを測定した値である。また、他の特殊演色評価数 R 8 、 R 1 0 等もより 1 0 0 % に近い値に改善されている。ランプ効率は、高い数値を示している。

[0158]

コーティング部材12と共に混合する蛍光体11は、Y-Gd-A | -O: Ceの蛍光体と、窒化物蛍光体と、を混合して用いている。該蛍光体は、密度が異なるため、密度がく、粒径が小さいものほど、一般には、早く沈降する。そのため、Y-Gd-A | -O: Ceの蛍光体が先に沈降し、窒化物蛍光体が次に沈降する。よって、同じコーティング材12と蛍光体11とを用いていても、発光装置の色調に色むらが生じることとなる。竹12と蛍光体の粒径を所定の大きさに制御し、Y-Gd-A | -O: Ceの 労光体の 大きなに制御し、Y-Gd-A | -O: Ceの 労光体とが、ほぼ同時に沈降することによって、色むらを生じないように改善することができる。

[0159]

<発光装置2>

[0160]

発光層としてピーク波長が青色領域にある460mmのInGaN系半導体層を有する発光素子101を用いる。該発光素子101には、P型半導体層とn型半導体層とが形成されており(図示しない)、該P型半導体層とn型半導体層には、リード電極102へ連結される導電性ワイヤ104が形成されている。リード電極102の外周を覆うように絶縁封止材103が形成され、短絡を防止している。発光素子101の上方には、パッケージ

30

•

105の上部にあるリッド106から延びる選光性の窓部107が設けられている。該選光性の窓部107の内面には、本発明に係る蛍光体108及びコーティング部材109の均一混合物がほぼ全面に塗布されている。発光装置1では、実施例1の蛍光体を使用する。パッケージ105は、角部がとれた一辺が8mm~12mmの正方形である。

[0161]

発光素子101で青色に発光した発光スペクトルは、反射板で反射した間接的な発光スペクトルと、発光素子101から直接射出された発光スペクトルとが、本発明の蛍光体108に照射され、白色に発光する蛍光体となる。

[0162]

以上のようにして形成された発光装置を用いて白色LEDランプを形成すると、 歩留まりは 9 9 % である。 このように、 本発明である発光ダイオードを使用することで、 量産性良く発光装置を生産でき、 信頼性が高く且つ色調ムラの少ない発光装置を提供することができる。

[0163]

<発光装置3>

図9は、本発明に係るキャップタイプの発光装置3を示す図である。

[0164]

発光装置1における部材と同一の部材には同一の符号を付して、その説明を省略する。

[0165]

発光装置3は、発光装置1のモールド部材15の表面に、蛍光体(図示しなり)を分散さ せた光透過性樹脂からなるキャップ16を被せることにより構成される。キャップ16は 、蛍光体を光透過性樹脂に均一に分散させている。この蛍光体を含有する光透過性樹脂を 発光装置1のモールド部材15の形状に 合する形状に成形している。または、所定の 型枠内に蛍光体を含有する光透過性樹脂を入れた後、発光装置1を該型枠内に押し込み、 成型する製造方法も可能である。キャップ16の光透過性樹脂の具体的材料としては、工 ポキシ樹脂、ユリア樹脂、シリコーン樹脂などの温度特性、耐候性に優れた透明樹脂、シ リカソル、ガラス、無機パインダーなどが用いられる。上記の他、メラミン樹脂、フェノ - ル樹脂等の熱硬化性樹脂を使用することができる。また、ポリエチレン、ポリプロピレ ン、ポリ塩化ピニル、ポリスチレン等の熱可塑性樹脂、スチレン-プタジエンプロック共 重合体、セグメント化ポリウレタン等の熱可塑性ゴム等も使用することができる。また、 蛍光体と共に拡散剤、チタン酸パリウム、酸化チタン、酸化アルミニウムなどを含有させ ても良い。また、光安定化剤や着色剤を含有させても良い。キャップ16に使用される蛍 光体は、実施例15を使用する。マウントリード180のカップ内に用いられる蛍光体1 1は、実施例15を用いる。しかし、キャップ16に蛍光体を用いるため、マウントリー ド13ののカップ内は、コーティング部材12のみでもより。

[0166]

このように構成された発光装置は、発光素子10から放出された光の一部は、キャップ16を通過する際に、実施例48の蛍光体により波長変換される。かかる波長変換された光と、蛍光体により波長変換されなかった育色系の光とが混合され、結果として、キャップ16の表面からは、白色系の光が外部へ放出される。

[0167]

【発明の効果】

以上のことから、本発明は、励起光源に、青色に発光する半導体発光素子を用いて、該半導体発光素子により照射された光が波長変換され、黄から赤領域に発光スペクトルを有する窒化物蛍光体を提供することができる。窒化物蛍光体を用いて、発光効率の良好なやや赤みを帯びた暖色系の白色の発光装置を提供することができる。

[0168]

また、本発明は、白色系に発光する発光装置であって、該白色系は、平均演色性評価数 R のが 8 の以上であり、特に赤みを示す特殊演色性評価数 R 9 が 7 の以上である発光装置を提供することができる。これにより、演色性に優れた白色系に発光する発光装置を提供す

U

20

30

40

50

```
(26)
ることができる。
[0169]
また、窒化物蛍光体と、青色に発光する蛍光体、緑色に発光する蛍光体、黄色に発光する
蛍光体とを1以上混合することにより、パステルカラーなどの多色化が図られた発光装置
を提供することができる。
[0170]
また、残光、粒径を所定の範囲に制御された窒化物蛍光体を提供することができる。
[0171]
さらに、発光特性、耐久性の向上が図られた窒化物蛍光体を提供することができるという
極めて重要な技術的意義を有する。
【図面の簡単な説明】
【図1】本発明に係る発光装置1を示す図である。
【図2】本発明に係る窒化物蛍光体の製造方法を示す図である。
【図3】実施例3の窒化物蛍光体をEX=460mmで励起したときの発光スペクトルを
示す図である。
【図4】実施例3の窒化物蛍光体の励起スペクトルを示す図である。
【図5】実施例3の窒化物蛍光体の反射スペクトルを示す図である。
【図6】実施例3の窒化物蛍光体を撮影したSEM写真である。
【図7】本発明に係る発光装置1の色度座標を示す図である。
                                              20
【図8】本発明に係る発光装置2を示す図である。
【図9】本発明に係るキャップタイプの発光装置3を示す図である。
【符号の説明】
P 1
    原料のCaを粉砕する。
    原料のCaを窒素雰囲気中で窒化する。
P 2
    この室化物を粉砕する.
P 3
    原料のSiを粉砕する。
P 4
    原料のSiを窒素雰囲気中で窒化する。
P 5
    Siの窒化物を粉砕する。
P 6
    Euの化合物Eu2Ogに、Bの化合物HgBOgを湿式退合する。
P 7
    Euの化合物Eu2Ogと、Bの化合物HgBOgとの混合物を、酸化雰囲気中
P 8
で焼成する。
    EuとBの混合物を粉砕する。
P 9
    Cのの窒化物、Siの窒化物、EuとBとの混合物を混合する。
P 1 0
     Caの窒化物、Siの窒化物、EuとBとの混合物をアンモニア雰囲気中で、
P 1 1
焼成する。
    Bが添加されたCa2Si5 N8:Euで表される蛍光体。
P 1 2
    基板
1
    半導体層
2
    電極
3
                                               40
    パンプ
    発光素子
1 0
    蛍光体
1 1
    コーティング部材
1 2
```

リードフレーム マウントリード

インナーリード

導電性ワイヤ

モールド部材

発光素子

リード電極

13a

1 3 b

1 4

1 5

1 0 1

1 0 2

103 絕緣封止材

104 導電性ワイヤ

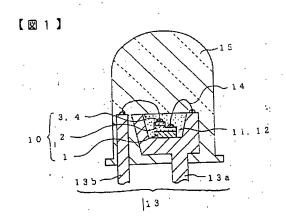
105 パッケージ

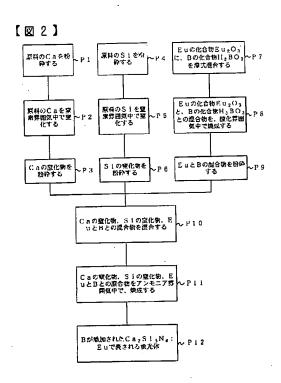
106 リッド

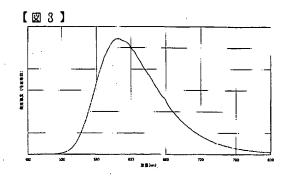
107 窓部

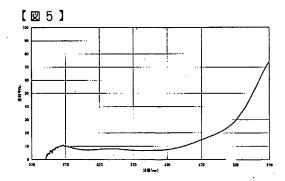
108 蛍光体

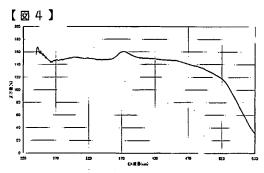
109 コーティング部材

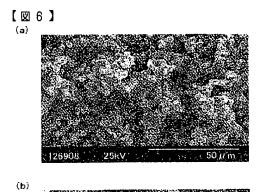


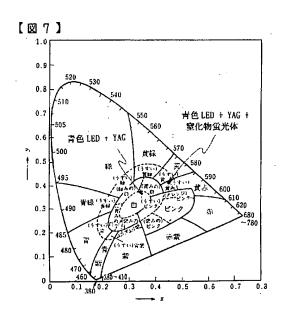


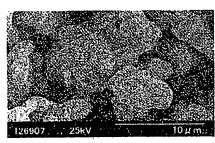




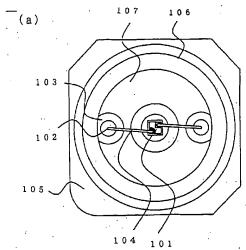




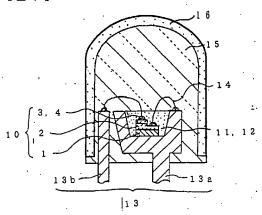


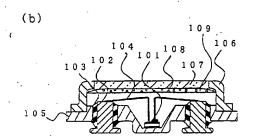






[図9]





フロントページの続き

(51)Int. Cl. 7 C 0 9 K 11/67 H 0 1 L 33/00

FΙ

テーマコード(参考)

C09K 11/66 C 0 9 K 11/67 H 0 1 L 33/00

F ターム(参考) 4H001 CA02 CA04 CA05 XA04 XA05 XA06 XA08 XA12 XA14 XA20 XA22 XA30 XA32 XA36 XA40 XA50 XA56 XA72 YA00 YA03 YA05 YA09 YA11 YA13 YA16 YA19 YA22 YA24 YA28 YA29 YA31 YA37 YA39 YA40 YA47 YA49 YA50 YA51 YA55 YA63 YA72 YA79 YA82 YA83 5F041 AA03 AA11 AA44 CA05 CA34 CA40 CA46 DA18 DA19 DB01

DB09 EE25 FF01